

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сибирское отделение Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физического материаловедения
Сибирского отделения Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт сильноточной электроники
Сибирского отделения Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт электрофизики
Уральского отделения Российской академии наук
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники»

ПРОГРАММА

VIII Международный Крейнделевский семинар

«Плазменная эмиссионная электроника»

05 - 11 июля 2026 года, Республика Бурятия, озеро Байкал,
село Сухая (туристическая база «Парк Сагаан Морин»)



Мероприятие проводится при финансовой поддержке
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники», tusur.ru



ПЭЭ'2026  БАЙКАЛ

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель:

Семенов Александр Петрович, д.т.н., профессор, Институт физического материаловедения СО РАН (Улан-Удэ) semenov@ipms.bsnet.ru.

Сопредседатели:

Гаврилов Николай Васильевич, чл.-к. РАН, Институт электрофизики УрО РАН (Екатеринбург) gavrilo@ier.uran.ru.

Коваль Николай Николаевич, д.т.н., профессор, Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск) nn.koval@hcei.ru.

Логачев Павел Владимирович, академик РАН, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск) P.V.Logatchov@inp.nsk.su

Номоев Андрей Валерьевич, д.ф.-м.н. Институт физического материаловедения СО РАН (Улан-Удэ) nomoevav@mail.ru

Ученый секретарь:

Воробьев М.С., д.т.н., старший научный сотрудник, Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск) vorobyovms@yandex.ru.

Члены:

Завьялов М.А., д.т.н., профессор, Всероссийский электротехнический институт - филиал ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е.И. Забабахина».

Залесский В.Г., д.ф.-м.н., ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси» (Минск, Беларусь).

Козырев А.В., д.ф.-м.н., профессор, Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск).

Королев Ю.Д., д.ф.-м.н., профессор, Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск).

Мартенс В.Я. д.т.н., профессор, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (Ставрополь).

Медовник А.В., д.т.н., доцент ФГАОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (Томск).

Метель А.С., д.ф.-м.н., профессор, ФГАОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» (Москва).

Окс Е.М., д.т.н., профессор, ФГАОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (Томск).

Ратахин Н.А., академик РАН, Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск).

Ремнев Г.Е., д.т.н., профессор, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (Томск).

Углов В.В., д.ф.-м.н., профессор, Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь).

ОБЗОР ПРОГРАММЫ

Воскресенье, 05 июля 2026 г.

8 ⁰⁰ -24 ⁰⁰	Прибытие и встреча участников семинара, размещение и регистрация в гостиничном комплексе «Бурятия»
16 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	Экскурсия в «Этнографический музей народов Забайкалья»

Понедельник, 06 июля 2026 г.

9 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Экскурсия в Дацан "Ринпоче Багша", экскурсия по городу Улан-Удэ, обзорная экскурсия «Музей научного наследия» и «Хранилище центра восточных рукописей и ксилографов» Института монголоведия, буддологии и тибетологии СО РАН
14 ⁰⁰	Выезд на туристическую базу «Парк Сагаан Морин» от гостиничного комплекса «Бурятия»
17 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	Прибытие и размещение
18 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	Ужин

Вторник, 07 июля 2026 г.

9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	Завтрак
-----------------------------------	---------

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА

Председатель заседания: д.т.н. Семенов Александр Петрович (Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ)	
10 ⁰⁰ -10 ¹⁵	Живой голос Юлия Ефимовича Крейнделя (запись выступления на защите докторской диссертации В.А.Груздева 11 октября 1989 года)
10 ¹⁵ -10 ³⁰	Приветствие участникам Семинара (оглашение письма Виталия Ефимовича Крейнделя (Красноярск))

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ:

I. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГЕНЕРАТОРАХ ПЛАЗМЫ, ЭМИССИОННЫЕ СВОЙСТВА ПЛАЗМЫ, ВОПРОСЫ ГЕНЕРАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ И ИОННЫХ ПУЧКОВ

Председатель заседания: д.т.н. Коваль Николай Николаевич (Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск)	
10 ³⁰ -10 ⁴⁵	О.Н. Алякринский, А.В. Акимов, П.А. Бак, К.И. Живанков, И.А. Журавлев, П.В. Логачев, О.А. Никитин, О.А. Павлов, И.В. Пензин, А.В. Петренко, Д.В. Петров, П.А. Полозова, Р.В. Протас, Д.Ф. Решетов, А.А. Старостенко. Особенности разделения интенсивного электронного пучка линейного индукционного ускорителя. Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск; Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е.И. Забабахина», Снежинск; Снежинский физико-технический институт - филиал

	ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»», Снежинск
10 ⁴⁵ -11 ⁰⁰	<u>В.Т. Астрелин</u> , <u>А.В. Бруль</u> , <u>В.И. Давыденко</u> , <u>П.П. Дейчули</u> . Формирование интенсивных ионных пучков в многоцелевых источниках с вторичной плазмой. Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск
11 ⁰⁰ -11 ¹⁵	<u>Д.А. Горьковская*</u> , <u>М.С. Воробьев</u> , <u>М.А. Мокеев</u> , <u>В.Н. Девятков</u> , <u>Н.Н. Коваль</u> , <u>П.В. Москвин</u> , <u>С.Ю. Дорошкевич</u> . Генерация электронного пучка в источнике с плазменным катодом на основе дуги низкого давления с жалюзийным перераспределяющим электродом переменной прозрачности. Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
11 ¹⁵ -11 ³⁰	<u>Д.Д. Зайцев*</u> , <u>Т.В. Коваль</u> , <u>Е.В. Островерхов</u> , <u>В.В. Денисов</u> , <u>С.С. Ковальский</u> . Моделирование газовой плазмы несамостоятельного тлеющего разряда в полом цилиндрическом катоде с двумя источниками электронов. Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
11³⁰-11⁴⁵	Кофе-пауза
Председатель заседания: д.т.н. Окс Ефим Михайлович (ФГАОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», Томск; Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск)	
11 ⁴⁵ -12 ⁰⁰	<u>Р.А. Картавцов*</u> , <u>С.Ю. Дорошкевич</u> , <u>М.С. Воробьев</u> , <u>А.А. Гришков</u> , <u>Н.Н. Коваль</u> , <u>Д.Ю. Чугунов</u> . Сильноточный высоковольтный тлеющий разряд с плазменным катодом. Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
12 ⁰⁰ -12 ¹⁵	<u>Т.В. Коваль</u> , <u>Р.А. Картавцов</u> , <u>М.С. Воробьев</u> , <u>Н.Н. Коваль</u> , <u>С.Ю. Дорошкевич</u> . Теоретический анализ и численное моделирование горения разряда низкого давления в электродной системе сеточного плазменного катода импульсного источника. Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
12 ¹⁵ -12 ³⁰	<u>А.В. Степанов</u> , <u>Г.Е. Ремнев</u> , <u>Ф.В. Конусов</u> , <u>С.К. Павлов</u> . Источник плазмы на основе разряда по поверхности сегнетокерамики. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск
12 ³⁰ -12 ⁴⁵	<u>М.В. Шандриков</u> , <u>А.А. Черкасов</u> , <u>Е.М. Окс</u> , <u>А.С. Бугаев</u> . Влияние инжекции электронов на масс-зарядовый состав плазмы магнетронной распылительной системы в реактивном режиме. Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
13⁰⁰-15⁰⁰	Обед
Председатель заседания: д.т.н. Воробьев Максим Сергеевич (Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск)	
15 ⁰⁰ -15 ¹⁵	<u>Г.Е. Ремнев</u> . Генерация импульсных ионных пучков наносекундной длительности в диодной системе Плютто – Люса. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск
15 ¹⁵ -15 ³⁰	<u>А.В. Казаков</u> , <u>Е.М. Окс</u> . Особенности функционирования импульсных форвакуумных плазменных источников широкоапертурного электронного пучка на основе дугового разряда. ФГАОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», Томск
15 ³⁰ -15 ⁴⁵	<u>А.Д. Тересов</u> , <u>Т.В. Коваль</u> , <u>П.В. Москвин</u> . Транспортировка интенсивного низкоэнергетического электронного пучка субмиллисекундной длительности в неоднородном продольном магнитном поле. Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
15 ⁴⁵ -16 ⁰⁰	<u>В.Я. Мартенс</u> . Влияние геометрии разрядной ячейки на характеристики высоковольтного разряда Пеннинга. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь
16¹⁵-16³⁰	Кофе-пауза

Председатель заседания: д.ф.-м.н. Коваль Тамара Васильевна (Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск)	
16 ³⁰ -16 ⁴⁵	<u>М.А. Мокеев*</u> , Д.А. Горьковская, В.Н. Девятков, М.С. Воробьев, А.А. Гришков, Н.Н. Коваль, Р.А. Картавцов. Способ комбинированного управления электронным пучком в источнике с многодуговым сеточным плазменным эмиттером. Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
16 ⁴⁵ -17 ⁰⁰	<u>М.С. Воробьев</u> , А.А. Гришков, Н.Н. Коваль, Т.В. Коваль. О механизме токопередачи в источниках электронов с сеточными плазменными эмиттерами на основе дугового разряда низкого давления с полым анодом. Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
17 ⁰⁰ -17 ¹⁵	<u>Д.Ю. Игнатов</u> . Влияние эмиссии электронов из плазмы вспомогательного разряда через цилиндрическую сетку на параметры плазмы основного разряда внутри протяжённого полого катода. Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
17 ¹⁵ -17 ³⁰	<u>Т.В. Коваль</u> , Д.Д. Зайцев, Д.Ю. Игнатов, В.В. Денисов, С.С. Ковальский. Численное моделирование формирования однородной низкотемпературной плазмы несамостоятельного тлеющего разряда в протяженной металлической трубке. Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
17 ³⁰ -17 ⁴⁵	<u>А.В. Казиев</u> . Промежуточные низковольтные формы разряда в переходах между импульсными магнетронными режимами и дугой. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
18 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	Ужин

Среда, 08 июля 2026 г.

9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	Завтрак
-----------------------------------	----------------

**ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ:
II. ГЕНЕРАТОРЫ ПЛАЗМЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ И ИОННЫХ ПУЧКОВ И
ОБОРУДОВАНИЕ НА ИХ ОСНОВЕ**

Председатель заседания: д.т.н. Семенов Александр Петрович (Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ)	
10 ⁰⁰ -10 ¹⁵	<u>Н.Н. Коваль</u> , Ю.Х. Ахмадеев, В.В. Денисов, М.С. Воробьев, Ю.Ф. Иванов, В.Н. Девятков, В.В. Шугуров. Создание и применение нового электронно-ионно-плазменного оборудования на основе разрядов низкого давления. Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
10 ¹⁵ -10 ³⁰	<u>Ю.И. Семенов</u> , Т.А. Девятайкина, Д.Ю. Болховитянов, И.А. Гусев, А.А. Жариков, В.А. Докутович, М.Ю. Косачев, А.Ю. Протопопов, В.В. Репков, Д.В. Сеньков, А.А. Старостенко, А.С. Цыганов. Установка для термической обработки поверхности материалов электронным пучком и её модификация. Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск; ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», Новосибирск; ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», Новосибирск
10 ³⁰ -10 ⁴⁵	<u>Н.В. Мамедов</u> , А.В. Казиев, Е.В. Третьяков, Д.Н. Синельников, Н.Е. Ефимов, А.В. Тумаркин, Д.В. Колодко. Характеристики источника ионов алюминия для установок ионной имплантации. АО «НИИ точного машиностроения», Москва, Зеленоград; ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный

	университет «МИФИ», Москва; Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино
10 ⁴⁵ -11 ⁰⁰	<u>В.А. Клименов, В.В. Фёдоров, А.А. Гришков, М.С. Воробьёв, Ю.В. Донцов, Дин Цзэжу, А.О. Чулков.</u> Модульный электронно-лучевой энергокомплекс с плазменным катодом для селективного сплавления порошка и послойного сплавления проволоки. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск; Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
11 ⁰⁰ -11 ¹⁵	<u>Н.Н. Коваль, Ю.Ф. Иванов, Н.А. Прокопенко, Е.А. Петрикова, М.С. Воробьев, А.Н. Шмаков.</u> Использование синхротронного излучения для исследования in situ роста многокомпонентных пленок переменного элементного состава методом плазменно-ассистированного электродугового напыления. Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
11 ¹⁵ -11 ³⁰	<u>Б.Б. Балданов, А.П. Семенов, Ц.В. Ранжуров.</u> PortPlaSter - портативный плазменный стерилизатор на основе плазменной струи атмосферного давления. Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ
11³⁰-11⁴⁵	Кофе-пауза
Председатель заседания: д.т.н. Ремнев Геннадий Ефимович (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск)	
11 ⁴⁵ -12 ⁰⁰	<u>В.В. Денисов.</u> Системы генерации пучково-плазменных образований на основе разрядов низкого давления для реализации процессов пучково-плазменной инженерии поверхности материалов и изделий. Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
12 ⁰⁰ -12 ¹⁵	<u>Е.В. Островерхов.</u> Система генерации протяжённых пучково-плазменных образований с инъекцией электронов из осесимметричного цилиндрического сетчатого эмиттера. Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
12 ¹⁵ -12 ³⁰	<u>С.В. Калашников, Т.А. Чимытов.</u> Экспериментальная установка индуктивно-связанной плазмы для анизотропного травления: конструкция, диагностика и общие результаты травления. Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ; ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», Улан-Удэ
12 ³⁰ -12 ⁴⁵	<u>В.Ю. Григорьев, Е.В. Берлин, Р.В. Дмитриев.</u> Система радиального магнетронного напыления на внутреннюю поверхность труб. ООО «Лаборатория вакуумных технологий +», Зеленоград
12 ⁴⁵ -13 ⁰⁰	<u>В.Ю. Григорьев, У.Л. Мишигдоржийн, К.А. Демин, Ю.В. Григорьев, А.П. Семенов, Н.Н. Коробков, А.С. Милонов, Н.С. Улаханов.</u> Модернизация электронно-лучевой энергоустановки с аксиальной электронной пушкой ЭПА-60-04.2. ООО «Лаборатория вакуумных технологий +», Зеленоград; Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ
13⁰⁰-15⁰⁰	Обед

**ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ:
III. НОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ МОДИФИКАЦИИ
ПОВЕРХНОСТИ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ И
ИОННЫХ ПУЧКОВ И ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЫ**

Председатель заседания: д.ф.-м.н. Курзина Ирина Александровна (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», Томск)	
15 ⁰⁰ -15 ¹⁵	<u>У.Л. Мишигдоржийн, А.П. Семенов.</u> Научно-технические основы модификации поверхности стали диффузионными слоями типа Fe-B-Me.

	Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ
15 ¹⁵ -15 ³⁰	<u>А.С. Каменецких</u> , П.В. Третников, С.В. Лепеха, Д.А. Мандрыгина. Тонкие пленки твердого аморфного электролита, синтезированные анодным термическим испарением LiPO ₃ в Ar/N ₂ плазме. Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург; ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург; Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург
15 ³⁰ -15 ⁴⁵	<u>Д.Б-Д. Цыренов</u> , А.П. Семенов, Н.С. Улаханов, И.А. Семенова. Осаждение в вакууме покрытий TiN-Cu на быстрорежущую сталь P18 методом плазмохимической технологии. Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ
15 ⁴⁵ -16 ⁰⁰	<u>А.А. Андронов*</u> . Электронно-лучевой синтез теплозащитных керамических покрытий в форвакуумной области давлений. ФГАОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», Томск
16¹⁵-16³⁰	Кофе-пауза
Председатель заседания: д.т.н. Денисов Владимир Викторович (Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск)	
16 ³⁰ -16 ⁴⁵	<u>Н.С. Улаханов*</u> , А.С. Милонов, А.П. Семенов, П.В. Москвин, А.Г. Тихонов. Исследование влияния электронно-пучковой обработки на технологические остаточные напряжения в диффузионных слоях на поверхности легированных сталей. Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ; Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск; ФГАОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», Иркутск
16 ⁴⁵ -17 ⁰⁰	<u>И.А. Галецкий*</u> , У.Л. Мишигдоржийн, А.С. Милонов, Н.С. Улаханов, А.П. Семенов, К.А. Демин, П.В. Москвин. Рационализация режимов электронно-пучковой обработки поверхности титанового сплава ВТ-6. Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ; Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
17 ⁰⁰ -17 ¹⁵	<u>И.В. Злобина</u> , Н.В. Бекренев, Р.Р. Сайфутяров, П.А. Жданов, С.С. Зыкова, А.В. Пасечная, С.И. Федорченко, Е.В. Иванов. СВЧ электромагнитное поле как фактор повышения эффективности работы интерфейса "матрица-волокно" в композитах на основе полиэфирэфиркетона. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина», Саратов; Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва
17 ¹⁵ -17 ³⁰	<u>С.А. Плотников</u> , А.Б. Владимиров, Е.А. Кравцов. Влияние ионной имплантации азота и покрытий нитрида титана на абразивную стойкость сплавов на основе железа и титана. Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург
17 ³⁰ -17 ⁴⁵	У.Л. Мишигдоржийн, А.С. Милонов, <u>А.П. Семенов</u> , Н.С. Улаханов*, К.А. Демин, Ю.И. Семенов, М.Ю. Косачев. Влияние электронно-лучевой обработки на микроструктуру и твердость борированного высокопрочного чугуна. Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ; Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск
18⁰⁰-20⁰⁰	Ужин

Четверг, 09 июля 2026 г.

9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	Завтрак
Председатель заседания: д.ф.-м.н. Номоев Андрей Валерьевич (Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ)	
10 ⁰⁰ -10 ¹⁵	<u>Е.А. Петрикова*</u> , Ю.Ф. Иванов, А.Д. Тересов, Н.А. Прокопенко, С.Ю. Дорошкевич. Поверхностное легирование силумина путем нанесения покрытия ZrTiCu и последующего его сплавления импульсным электронным пучком с целью улучшения прочностных и пластических характеристик. Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
10 ¹⁵ -10 ³⁰	<u>К.А. Демин*</u> , С.С. Агнаев, С.Д. Дондуков, А.Н. Хаглеев, У.Л. Мишигдоржийн. Модификация поверхности полипропилена в плазме скользящей дуги. Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ
10 ³⁰ -10 ⁴⁵	<u>А.С. Милонов</u> , Н.С. Улаханов, У.Л. Мишигдоржийн, А.П. Семенов, В.А. Павлюченко. Моделирование процессов формирования слоев боридов переходных металлов на поверхности высокопрочных чугунов. Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ; Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск
10 ⁴⁵ -11 ⁰⁰	<u>А.Б. Лупсанов*</u> , С.А. Номоев, У.Л. Мишигдоржийн, С.Б. Лупсанов, А.С. Милонов, А.В. Номоев. Лазерное легирование инструментальной стали порошками В ₄ С и В ₄ С-Аl: упрочнение и трещиностойкость композитного слоя. ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», Улан-Удэ; Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ; ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
11 ⁰⁰ -11 ¹⁵	<u>А.Г. Коржова</u> , У.В. Хомутова, А.А. Брюзгина, О.А. Лапуть, Ю.Х. Ахмадеев, <u>И.А. Курзина</u> . Плазменное модифицирование как способ функционализации поверхности полимерных материалов медицинского назначения для иммобилизации биоактивных веществ. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», Томск; Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск
11 ¹⁵ -11 ³⁰	<u>С.Д. Дондуков*</u> , С.С. Агнаев, К.А. Демин, А.Н. Хаглеев. Исследование поверхности волокна конопли модифицированного в плазме атмосферного давления. Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ; ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», Улан-Удэ
11 ³⁰ -11 ⁴⁵	Кофе-пауза
Председатель заседания: д.т.н. Каменецких Александр Сергеевич (Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург)	
11 ⁴⁵ -12 ⁰⁰	<u>Б.Е. Мархадаев</u> , Б.А. Дышенов, У.Л. Мишигдоржийн, А.В. Номоев, С.А. Лысых. Влияние меди на кинетику роста борированного слоя на поверхности углеродистых сталей. Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ
12 ⁰⁰ -12 ¹⁵	<u>С.В. Калашников</u> , Т.А. Чимытов. Анизотропное травление стекла в индуктивно-связанной плазме CF ₄ /Ar: зависимость скорости и качества от технологических параметров. Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ; ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени

	Доржи Банзарова», Улан-Удэ
12 ¹⁵ -12 ³⁰	С.С. Агнаев*, С.Д. Дондуков, К.А. Демин, А.Н. Хаглеев. Влияние низкотемпературной плазмы атмосферного давления на химический состав поверхности полипропилена. Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ; ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», Улан-Удэ
12 ³⁰ -12 ⁴⁵	И.А. Южаков*, Б.З. Гармаев, Д.Г. Цыдыпов, А.В. Номоев. Влияние нанопорошка SiO ₂ на микроволновые и реологические свойства высоконаполненного силиконового композита SilcoTin 25/P-10. Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ
12 ⁴⁵ -13 ⁰⁰	Б.З. Гармаев, К.В. Зобов, В.Р. Гапоненко, А.В. Номоев, С.П. Бардаханов. Оценка скорости звука на основе модели эффективного модуля Юнга в нанопорошке SiO ₂ , синтезированной высокочастотным электронным пучком. Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ; Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Новосибирск
13 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	Обед
Председатель заседания: д.т.н. Семенов Александр Петрович (Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ)	
15 ⁰⁰ -15 ³⁰	Заседание Программного комитета, голосование
15 ³⁰ -16 ⁰⁰	Награждение дипломами молодых ученых за лучшие доклады
16 ⁰⁰ -16 ⁴⁵	Заседание круглого стола, принятие решения
16 ⁴⁵ -17 ⁰⁰	Фотографирование
18 ⁰⁰ -22 ⁰⁰	Товарищеский ужин

Пятница, 10 июля 2026 г.

9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	Завтрак
10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Выезд в г. Улан-Удэ участников, вылетающих рейсом WZ1094 в г. Томск, размещение в гостиничном комплексе «Бурятия»
13 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	Обед
15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	Дискуссия
18 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	Ужин

Суббота, 11 июля 2026 г.

9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	Завтрак
12 ⁰⁰	Выезд в г. Улан-Удэ
16 ⁰⁰	Прибытие в г. Улан-Удэ, размещение в гостиничном комплексе «Бурятия»

Воскресенье, 12 июля 2026 г.

8 ⁰⁰ -24 ⁰⁰	Отъезд участников семинара из г. Улан-Удэ
-----------------------------------	---

*) - доклады молодых ученых